

1SMB10CAT3系列

瓦峰值功率齐纳 瞬态电压 抑制器

双向*

在SMB系列是专为保护电压敏感组件由高压，高能量瞬变。他们有出色的钳位能力，高浪涌能力，低齐纳阻抗和快速响应时间。在SMB系列供应安森美半导体专有的，高性价比，高可靠性Surmetic封装，非常适合于在通信中使用系统，汽车，数字控制，过程控制，医疗设备，商用机器，电源和许多其他工业/消费应用。

特点

- 工作峰值反向电压范围 -10 V至75 V
- 标准齐纳击穿电压范围 -11.7 V至91.7 V
- 峰值功率 -600瓦 @ 1毫秒
- ESD额定值3类 (>16千伏) 每人体模型
- 最大钳位电压 @峰值脉冲电流
- 低漏 < 5 mA 上述10 V
- UL 497B用于隔离回路电路保护
- 响应时间通常 < 1纳秒
- 无铅包可用

机械特性

案例： 无空隙，传递模塑，热固性塑料
表面处理 所有的外部表面耐腐蚀和导线

随手可焊

最大外壳焊接温度的目的：

260°C 10秒

信息： 修饰的L形弯曲，提供更多的接触面积，以键合焊盘

极性： 极性带，也不会指示

安装位置： 任何



ON Semiconductor®

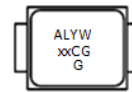
<http://onsemi.com>

塑料表面贴装
齐纳管
瞬态抑制器
10-78 V, 600 W峰值功率



SMB
案例403C
塑料

标记图



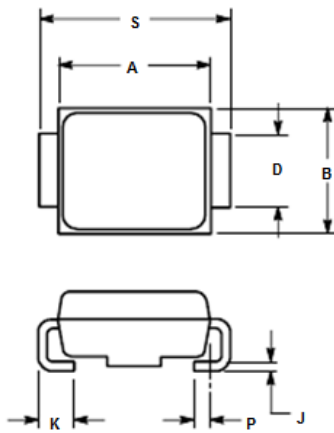
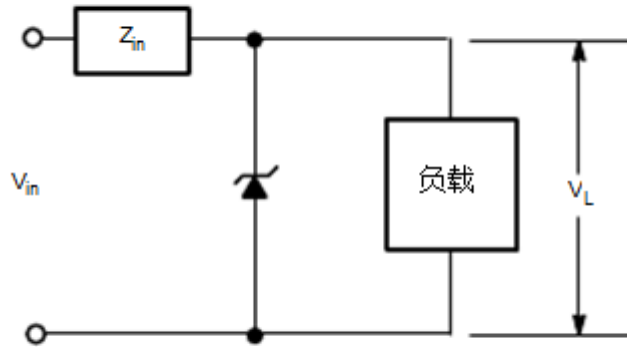
A = 大会地点
Y = 年
WW = 工作周
XXC = 具体设备守则
(请参阅表第3页)
G = Pb-Free包装
(注：微球可在任一位置)

订购信息

设备 *	包	航运 †
1SMBxxCAT3	SMB	2500 / 磁带&卷轴
1SMBxxCAT3G	SMB (无铅)	2500 / 磁带&卷轴

*在“T3”的后缀是指一个13英寸的卷轴。

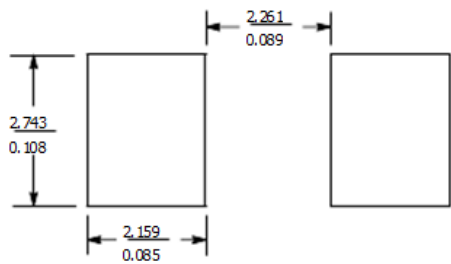
通常的保护电路



- 注释:
1. 尺寸和公差符合ANSI Y14.5M, 1982年.
 2. 控制尺寸: 英寸.
 3. D尺寸应在实例 给P.

	英寸		MILLIMETERS	
DIMMN	最大	标	最大	标
A	0.160	0.180	4.06	4.57
B	0.130	0.150	3.30	3.81
C	0.075	0.095	1.90	2.41
D	0.077	0.083	1.96	2.11
H	0.0020	0.0060	0.051	0.152
J	0.006	0.012	0.15	0.30
K	0.030	0.060	0.76	1.27
P	0.020 REF		0.51 REF	
S	0.205	0.220	5.21	5.59

焊接足迹*



尺数 1 $\frac{\text{mm}}{\text{英寸}}$

*有关我们的无铅战略和焊接的其他信息
 详细信息, 请下载安森美半导体焊接与
 安装技术参考手册, SOLDERRM / D.